Высокотемпературное равновесие дефектов в ZnSe : In

Nöges, Märt; Varvas, Jüri; Nirk, Tiit; Kallavus, Urve Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 67-76

Замораживание высокотемпературного состояния дефектов в сильнолегированном селениде кадмия

Türn, Leo Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 53-58

К выбору конструкции фоточувствительных р-п переходов на основе антимонида индия

Gavrilov, Aleksei; Danilov, J.V.; Katšurin, G.A.; Mere, Arvo Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 105-112

Концентрационная зависимость отдельных подполос спектров фотолюминесценции ZnS : Cu : Cl

Krustok, Jüri; Mädasson, Jaan Физическая химия соединений АИВВИ 1984 / с. 11-16

Концентрационная зависимость эффективных масс дырок в германии

Paat, Aadu; Uder, Ülo Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 95-103

Микрофотопреобразователи на базе многозернистого сульфида кадмия

Iļjina, Natalja; Varema, Tiit Физическая химия соединений АИВВИ 1984 / с. 41-48

Монозернистые слои на основе фотопроводящего сульфида кадмия

Hiie, Jaan; Mellikov, Enn; Varema, Tiit; Iļjina, Natalja Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 3-11

Некоторые вопросы создания регулярных монозернистых слоев

Iļjina, Natalja; Hiie, Jaan Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 13-18

О причинах разброса параметров таблеточных фоторезисторов из селенида кадмия

Altosaar, Mare; Valdna, Vello Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 19-26

О работе таблеточных фоторезисторов в кремнийорганической жидкости

Valdna, Vello Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 27-34

Обработка данных высокотемпературной электропроводимости селенида кадмия на ЭВМ

Türn, Leo Физическая химия соединений АИВВИ 1984 / с. 35-40

Образование пленок CdS и CdZnS при химической пульверизации растворов

Krunk, Malle; Mellikov, Enn; Karpenko, I.V. Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 35-42

Определение равновесия дефектов в легированных бинарных полупроводниковых соединениях

Türn, Leo Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 43-51

Оптические и фотоэлектрические свойства пленок сульфида кадмия, химически осажденных пульверизацией

Kern, Karin; Tilling, Aino; Antsov, U. Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 59-65

Поглощение СВЧ-излучения в примесном сульфиде кадмия

Palmre, Õie; Mellikov, Enn; Hiie, Jaan; Tuvike, Tiit; Klepikova, N.V. Физическая химия соединений АИВВИ 1984 / с. 59-65

Равновесная структура дефектов в CdSe : Al

Nirk, Tiit; Õpik, Andres Физическая химия соединений АИВВИ 1984 / с. 3-9

Растворимость галлия в сульфиде цинка

Lott, Kalju; Višņakov, A.V.; Raukas, Maie Физическая химия соединений АИВВИ 1984 / с. 17-27

Растворимость индия в сульфиде цинка

Lott, Kalju; Višņakov, A.V.; Raukas, Maie Физическая химия соединений АИВВИ 1984 / с. 29-33

Структура дефектов в CdSe : Ag

Nirk, Tiit; Õpik, Andres Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 77-85

Структура фазовой диаграммы Zn-Ag-S и растворимость серебра в сульфиде цинка

Lott, Kalju; Višņakov, A.V.; Raukas, Maie; Varvas, Jüri Физическая химия соединений АИВВИ 1981 / с. 87-93

Структурные и оптические свойства химически пульверизованных пленок сульфида кадмия

Krunk, Malle; Mellikov, Enn; Sork, Eeve; Vidrevitš, Marina Физическая химия соединений АИВВИ 1984 / с. 49-58